

## 大見研究室 和文 論文リスト

## 1993 年

- 411(M) 大見忠弘、「G bit 時代に思いを馳せて」、ブレイクスルー、No.79、(株リアライズ社)、pp.7-11、1993 年 1 月。
- 412(M) 大見忠弘、「東北大学からの提案－2001年の半導体技術」、ブレイクスルー、No.79、(株リアライズ社)、pp.24-33、1993 年 1 月。
- 413(M) 大見忠弘、「最近の超クリーン化技術の研究状況と展望」、精密工学会誌、Vol.59、No.1、(社)精密工学会)、pp.53-58、1993 年 1 月。
- 414(M) 大見忠弘、川田幸司、高橋慎治、「APIMSの原理と半導体製造プロセスへの応用」、セミコンダクターワールド、第 12 巻、第 3 号、(株)プレスジャーナル)、pp.122-131、1993 年 2 月号。
- 415-1(P) 大見忠弘、「シリコンウェハ表面の洗浄と表面微細構造(マイクロラフネス)」、超精密加工専門委員会第 15 回研究会資料、(精密工学会 超精密加工専門委員会)、pp.1-7、1993 年 2 月。
- 416(P) 大見忠弘、新田雄久、「固液界面相互作用の理解が加速する新しいウェットプロセスの確立を目指して」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 17、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、1993 年 2 月。
- 417-1(P) 去来川辰彦、木暮雅彦、二ツ木高志、大見忠弘、「シリコンウェハ表面への有機物の吸着とオゾン添加超純水による除去」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 17、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.125-146、1993 年 2 月。
- 418(P) 尾形保一、木村一哉、田中富士夫、二ツ木高志、木暮雅彦、毛塚健彦、去来川辰彦、高野順、今岡孝之、大見忠弘、「ウェットケミカルプロセスに於ける過酸化水素水中のTOCの影響」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 17、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.149-166、1993 年 2 月。
- 419-1(P) 大谷克秀、大見忠弘、井原清彦、「PFA表面における金属不純物の吸着脱離」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 17、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.187-201、1993 年 2 月。
- 420(P) 川辺一郎、村瀬玄一、米沢勲、前野又五郎、三木正博、大見忠弘、「ICP-MS直接法による半導体薬品の評価」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 17、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.301-318、1993 年 2 月。
- 421(P) 三島博之、大見忠弘、「イオン性物質によるイソプロピルアルコールの抵抗率変化」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 17、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.343-358、1993 年 2 月。
- 422(P) 須藤誠司、大見忠弘、三島博之、「イソプロピルアルコールによる除電機構」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 17、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.361-375、1993 年 2 月。
- 423(P) 大見忠弘、「一巻頭言－半導体用薬品精製回収技術」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.5、No.1、(半導体基盤技術研究会)、pp.1-4、1993 年 2 月。
- 336-2(P) 三木正博、前野又五郎、福留敏郎、宮下雅之、鶴和枝、大見忠弘、「フッ素回収技術」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.5、No.1、(半導体基盤技術研究会)、pp.5-25、1993 年 2 月。
- 424(M) 千葉和郎、高橋麗子、前野又五郎、泉浩人、大見忠弘、「金属表面のフッ化不動態化技術の開発」、アルトピア VOL.23、NO.2、(カロス出版)、pp.9-15、1993 年 2 月。
- 196-2(M) 大見忠弘、「超LSI製造におけるウルトラクリーン化技術と膜分離技術の役割」、膜分離技術『最近の進歩』、(膜分離技術振興協会)、pp.89-97、1993 年 2 月。

- 425(M) 大見忠弘、「二周波励起プラズマプロセス装置による装置標準化の提案」、ブレイクスルー、No.80-81、(株リアライズ社)、pp.20-25、1993年3月。
- 426(P) 大見忠弘、新田雄久、「超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップ No.23 序文-資源材料を回収再生する Closed Manufacturing System の確立を目指して-」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 23、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、1993年3月。
- 427(P) 三木正博、前野又五郎、福留敏郎、宮下雅之、鶴和枝、大見忠弘、「フッ素系薬品回収技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 23、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.43-71、1993年3月。
- 428(P) 大見忠弘、「一巻頭言-Scientific Semiconductor Manufacturing を目指して-About な技術から Accurate な技術へ」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.5、No.2、(半導体基盤技術研究会)、pp.1-6、1993年3月。
- 429-1(P) 大見忠弘、「新たな飛躍期を迎えるシリコン技術」、第40回応用物理学関係連合講演会 講演予稿集No. 0、(応用物理学会、計測自動制御学会、日本結晶学会、日本真空協会、日本電子顕微鏡学会、日本物理教育学会、日本分光学会)、29p-GD-4、pp.1343、1993年3月。
- 429-2(M) 大見忠弘、「新たな飛躍期を迎えるシリコン技術」、応電分科会の歩み-50周年記念-、(応用物理学会 応用電子物性分科会)、pp35-36、1993年4月。
- 430(M) 大見忠弘、「クローズド・マニュファクチュアリング-完全制御された表面を求めて-」、ブレイクスルー、No.82、(株リアライズ社)、pp.26-31、1993年4月。
- 431-1(P) 大見忠弘、新田雄久、「超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.18(健全な繁栄を継続するための半導体技術)序文」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 18、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.(1)-(4)、1993年4月。
- 432(P) 大谷克秀、大見忠弘、井原清彦、「フッ素樹脂成形品の表面平滑化とその効果」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 18、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.21-45、1993年4月。
- 433-1(P) 名取巖、市川明宏、大見忠弘、「プロセスチャンバの In-situ クリーニング技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 18、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.81-95、1993年4月。
- 434-1(P) 大見忠弘、高橋慎二、泉浩人、前野又五郎、「Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and NiF<sub>2</sub> Passivation Technology of Metal Surface」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 18、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.113-137、1993年4月。
- 435-1(P) 小西信博、柴田直、大見忠弘、「半導体製造装置用ガス排気系の設計論」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 18、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.141-156、1993年4月。
- 436(P) 柴田直、大見忠弘、「現技術の限界と新概念への期待」、第6回回路とシステム軽井沢ワークショップ、((社)電子情報通信学会)、pp.197-200、1993年4月。
- 437(P) 小谷光司、柴田直、大見忠弘、「イオン注入によるMOSデバイスのチャージアップ・ダメージ」、第5回ブレイクスルーセミナー(株リアライズ社)、pp.81-85、1993年4月。
- 438(P) 安井信一、二ツ木高志、米川直道、大見忠弘、「オゾン添加超純水を用いたシリコンウェハ表面の有機物除去」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.93、No.7、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM93-1、pp.1-8、1993年4月。
- 439(P) 須藤誠司、森永均、大見忠弘、三島博之、「イソプロピルアルコールによる除電機構」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.93、No.7、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM93-3、pp.15-22、1993年4月。
- 440(P) 中村亘、松本光市、牧原康二、山本和馬、高野順、大見忠弘、「薄い酸化膜質のSiウェハ面方位依存性」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.93、No.7、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM93-6、pp.37-42、1993年4月。

- 441(P) 柴田直、大見忠弘、「ニューロンMOSTランジスタの拓く新しい論理LSIの世界」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.93、No.18、集積回路、((社)電子情報通信学会)、論文番号 ICD93-6、pp.39-46、1993年4月。
- 442(M) 大見忠弘、「2001年半導体工場の姿—Most Cost Effective な生産を求めて—」、ブレイクスルー、No.83、(株)リアライズ社)、pp.44-48、1993年5月。
- 443(P) 大見忠弘、柴田直、中村佳夫、宮脇守、「21世紀のエレクトロニクスを切り拓く新しいデバイスプロセスの開発」、テレビジョン学会技術報告—情報入力—、Vol.17、No.30、IPU'93-25、((社)テレビジョン学会)、pp.13-17、1993年5月。
- 444(M) 大見忠弘、「しなやかな情報処理を実現する世界初の4端子デバイス(1)」、電子技術 Vol.35、No.6、(日刊工業新聞社)、pp.105-109、1993年6月。
- 445(M) 大見忠弘、「装置冷却と真空排気系技術—サポータリングテクノロジー—」、ブレイクスルー、No.84、(株)リアライズ社)、pp.22-25、1993年6月。
- 446(M) 大見忠弘、「クォータミクロン時代の半導体技術」、計測と制御、Vol.32、No.6、((社)計測自動制御学会)、pp.449-451、1993年6月。
- 447(P) 大見忠弘、新田雄久、「超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップ No.24 序文-高性能低価格半導体用ガス配管系を実現するインスペクションフリー加工技術-」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 24、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.(1)-(4)、1993年6月。
- 448(P) 石川亨一、大見忠弘、「特殊ガス成分高感度計測技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 24、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.3-12、1993年6月。
- 449(P) 石原良夫、池田拓也、羽坂智、高橋俊道、長谷川英晴、山根すみ代、福嶋良助、大見忠弘、「HC1の電気伝導度計測」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 24、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.27-36、1993年6月。
- 450(P) 篠原努、山路道雄、池田信一、大見忠弘、「超小型継手の開発による配管施工の高性能化」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 24、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.39-52、1993年6月。
- 451(P) 小山智之、三好伸二、高橋慎治、小嶋努、大見忠弘、「非腐食性・非触媒性 Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>ステンレス特殊ガス配管技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 24、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.55-67、1993年6月。
- 452(P) 三好伸二、末長徹男、川田幸司、大見忠弘、水口泰光、「金属ヒュームフリー溶接技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 24、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.71-85、1993年6月。
- 453(P) 水口泰光、大見忠弘、「半導体用チューブ溶接器」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 24、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.89-97、1993年6月。
- 454(P) 大見忠弘、新田雄久、「超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップ No.25 序文-薄い酸化膜高性能化への道-」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 25、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.(1)-(4)、1993年6月。
- 455(P) 大見忠弘、「薄い酸化膜高性能化への総論」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 25、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.3-25、1993年6月。
- 456(M) 大見忠弘、三好伸二、「超高純度ガス供給の新技術」、セミコンダクターアニュアル(ガス供給編)ガスメディア臨時増刊—、(テス出版株)、pp.14-19、1993年6月。
- 457(M) 大見忠弘、「しなやかな情報処理を実現する世界初の4端子デバイス(2)」、電子技術、Vol.35、No.7、(日刊工業新聞社)、pp.60-63、1993年7月。
- 458(P) 杉山和彦、大見忠弘、中村雅一、水口泰光、三好伸二、阪中隆、大木厚志、田中剛、「メンテナンスフリーを目指す高品質・低価格CRP処理ガス供給技術」、第11回大阪酸素—半導体セミナー—講演集—21世紀へ向けての提案—、(大阪酸素工業株)、pp.4-32、1993年7月。

- 459(P) 都田昌之、宍戸昌広、菅野洋一、梅田優、新田雄久、斎藤由雄、大見忠弘、「超清浄ウェハ表面を確保するN2トンネルウェハ搬送技術」、第11回大阪酸素－半導体セミナー－講演集－21世紀へ向けての提案－、(大阪酸素工業株)、pp.33-57、1993年7月。
- 460-1(P) 大見忠弘、「半導体ガス供給系の高性能化が半導体製造プロセスに如何に重要か－半導体製造プロセスの高度化がトータルコストを低減する－」、第5回超高純度ガス供給系技術懇談会－技術資料－、(株)ウルトラクリーンテクノロジー研究所、(株)長野計器製作所)、pp.1-5、1993年7月。
- 461-1(P) 大見忠弘、「完全耐腐食性・非触媒性ステンレス表面処理技術－プロセスパラメータの完全制御を可能にする超高純度ガス配管系－」、第5回超高純度ガス供給系技術懇談会－技術資料－、(株)ウルトラクリーンテクノロジー研究所、(株)長野計器製作所)、pp.6-19、1993年7月。
- 462-1(P) 大見忠弘、「腐食の困難を克服する金属ヒュームフリー超精密溶接技術－コンタミフリーかつ長寿命のガス配管系を可能にする溶接技術－」、第5回超高純度ガス供給系技術懇談会－技術資料－、(株)ウルトラクリーンテクノロジー研究所、(株)長野計器製作所)、pp.20-31、1993年7月。
- 463-1(P) 大見忠弘、「Inspection-Free Installation－高性能化と標準化が配管施工技術を変える－」、第5回超高純度ガス供給系技術懇談会－技術資料－、(株)ウルトラクリーンテクノロジー研究所、(株)長野計器製作所)、pp.32-40、1993年7月。
- 464-1(P) 大見忠弘、「Inspection-Free Installation(継手編)－減圧リークチェック評価を不要にする新しい継手とその施工方法－」、第5回超高純度ガス供給系技術懇談会－技術資料－、(株)ウルトラクリーンテクノロジー研究所、(株)長野計器製作所)、pp.41-54、1993年7月。
- 465-1(P) 大見忠弘、「完全自動化ガス供給システム」、第5回超高純度ガス供給系技術懇談会－技術資料－、(株)ウルトラクリーンテクノロジー研究所、(株)長野計器製作所)、pp.55-62、1993年7月。
- 466(P) 大見忠弘、「高性能マルチチャンバシステムにおける2周波励起プラズマプロセス」、第10回薄膜スクール資料－高度化する薄膜生成技術の基礎から最先端まで－、(日本学術振興会 薄膜第131委員会)、pp.135-150、1993年7月。
- 467(M) 大見忠弘、「超高純度ガス技術」、ブレイクスルー、No.85、(株)リアライズ社)、pp.30-35、1993年7月。
- 468(M) 去来川辰彦、大見忠弘、「半導体分野へのオゾン添加超純水の適用」、神鋼パンテック技報、Vol.37、No.2 通巻129号、(神鋼パンテック株技術研究所)、pp.30-35、1993年7月。
- 469(P) 大見忠弘、新田雄久、「超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.19 序文－Scientific Semiconductor Manufacturing を可能にする評価・分析技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 19、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.(1)-(4)、1993年7月。
- 470(P) 中川佳紀、泉浩人、大見忠弘、「無水HFを用いた固体表面吸着水分量の測定」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 19、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.43-51、1993年7月。
- 471(P) 青谷征二、早川昌和、塚崎和生、大見忠弘、「ナノマスターを用いた高性能フィルターの検定」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 19、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.101-121、1993年7月。
- 472(P) 稲葉仁、吉田隆紀、岡田孝夫、大見忠弘、「静電気力による微粒子付着と帯電防止技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 19、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.155-166、1993年7月。
- 473(P) 森永均、二ツ木高志、大見忠弘、淵田英嗣、小田正明、林主税、「10nm程度金属超微粒子のシリコン表面における挙動」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 19、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.169-178、1993年7月。
- 474(P) 中村亘、牧原康二、森田瑞穂、大見忠弘、「ウルトラクリーン酸化で形成した極薄ゲート酸化膜のホットキャリア耐性」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.93、No.172、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号SDM93-63、pp.51-56、1993年7月。

- 475(P) 大見和幸、二ツ木高志、牧原康二、山本和馬、大見忠弘、「MOSチャネル移動度のSi/SiO<sub>2</sub>界面マイクロラフネス依存性」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.93、No.172、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM93-68、pp.85-89、1993年7月。
- 476(P) 山田尚、星司、竹脇利至、柴田直、大見忠弘、新田雄久、「大電流ストレスによるジャイアント・グレインCu配線のエレクトロマイグレーション耐性評価」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.93、No.172、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM93-69、pp.91-98、1993年7月。
- 477(P) 大見忠弘、二ツ木高志、末長徹男、陶山誠、泉浩人、「クリーン化技術の全貌」、磁性材料研究会・電子材料表面処理技術部会合同例会資料、((社)電気化学協会・磁性材料研究会、(社)表面処理技術協会・電子材料表面処理技術部会)、pp.3-34、1993年7月。
- 478(M) 高橋麗子、千葉和郎、前野又五郎、大見忠弘、「弗化不動態処理品」、電子材料8月号、第32巻第8号、(株)工業調査会)、pp.22-23、1993年8月。
- 479(P) 大見忠弘、柴田直、「インテリジェントデバイス—しなやかな知的情報処理を可能にする4端子デバイスエレクトロニクス」、インテリジェント材料フォーラム第7回ワークショップ講演資料、((社)未踏科学技術協会)、pp.17-34、1993年8月。
- 480(P) 富田和朗、中田明良、右田智裕、柴田直、大見忠弘、新田雄久、「450℃超低温接合形成のためのメタル汚染低減イオン注入技術」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.93、No.191、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM93-73、pp.9-16、1993年8月。
- 481(P) 米川直道、國本文智、Frederic W.Kern.r、大見忠弘、「スピンドクリーニング法によるシリコンウェハのウルトラクリーン・ウェット洗浄技術」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.93、No.191、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM93-75、pp.25-32、1993年8月。
- 482(P) 松浦孝、室田淳一、鈴江孝司、澤田康次、大見忠弘、「シリコンの自己制限型原子層エッチング」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.93、No.192、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM93-79、pp.1-7、1993年8月。
- 483(P) 鈴木浩、前田祐二、森田瑞穂、大見忠弘、「コールドサセプタを用いた高速選択タングステンCVDプロセス」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.93、No.192、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM93-80、pp.9-15、1993年8月。
- 484(P) 大見忠弘、「ウルトラクリーン化—完全な再現性—Low Cost Production」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.5、No.4、(半導体基盤技術研究会)、pp.1-2、1993年8月。
- 485(M) 去来川辰彦、大見忠弘、「オゾン添加超純水洗浄」、ブレイクスルー、No.86-87、(株)アライズ社)、pp.27-29、1993年9月。
- 486(M) 大見忠弘、「ウルトラクリーンウェハ表面の実現と超高純度薬品・超々純水技術」、ブレイクスルー、No.86-87、(株)アライズ社)、pp.34-38、1993年9月。
- 487(P) 大見忠弘、「しなやかな知的情報処理を可能にする4端子デバイスエレクトロニクス」、東京工業大学精密工学研究所 新研究組織発足記念シンポジウム論文集、(東京工業大学精密工学研究所)、pp.108-111、1993年9月。
- 488(M) 大見忠弘、「ウルトラクリーン化半導体プロセス技術」、TCIセミナーテキスト、(つくば研究支援センター)、1993年9月。
- 489(P) 柴田直、山下毅雄、大見忠弘、「ニューロンMOSウィナー・テーク・オール回路とその連想メモリへの応用」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.93、No.231、集積回路、((社)電子情報通信学会)、論文番号 ICD93-98、DSP93-59、pp.31-38、1993年9月。
- 490(P) 中村雅一、大木厚志、大見忠弘、「APIMSを用いた特殊材料ガス中の間接水分濃度測定」、第54回応用物理学会学術講演会講演予稿集No. 2、((社)応用物理学会)、27a-ZD-6、pp.640、1993年9月。
- 491(P) 末長徹男、白井泰雪、大見忠弘、「ステンレス配管の放出水分特性評価」、第54回応用物理学会学術講演会講演予稿集No. 2、((社)応用物理学会)、27a-ZD-7、pp.640、1993年9月。

- 492(M) 大見忠弘、「超高純度薬品・超々純水技術」、ブレイクスルー、No.88、(株リアライズ社)、pp.34-38、1993年10月
- 493(P) 大見忠弘、「シリコン表面極微細構造が極薄酸化膜に与える影響」、薄膜131委員会第168回研究会資料、(日本学術振興会)、pp.1-10、1993年10月。
- 494(M) 大見忠弘、安田正志、「サブハーフミクロンULSI製造ー重要度を増す微振動対策ー」、日経マイクロデバイス1993年11月号、No.101、(日経BP社)、pp.105-112、1993年11月。
- 495-1(M) 大見忠弘、「2001年半導体工場の収支総決算ー1」、ブレイクスルー、No.89、(株リアライズ社)、pp.26-31、1993年11月
- 495-2(P) 大見忠弘、「超LSI製造におけるウルトラクリーン技術と膜分離技術の役割」、食品膜技術懇談会第5回秋季研究例会講演要旨、(食品膜技術懇談会)、pp.73-77、1993年11月。
- 495-3(P) 大見忠弘、「我が国半導体産業の現状と将来の見通し」、半導体国際交流シンポジウム '93、((財)半導体国際交流センター)、pp.8-26、1993年11月。
- 496(W) 大見忠弘、「総括」、第3回マイクロエレクトロニクス研究会(大見研究室年次研究討論会)プロシーディング、pp.173-192、1993年11月。
- 497(W) ニツ木高志、中村亘、牧原康二、大見和幸、山本和馬、藪根辰弘、大見忠弘、「水素ラジカル水分酸化による高性能性・極薄酸化膜形成技術」、第3回マイクロエレクトロニクス研究会(大見研究室年次研究討論会)プロシーディング、pp.193-198、1993年11月。
- 498(W) 河合泰明、小西信博、渡辺仁三、大見忠弘、「450℃ゲート酸化膜形成技術」、第3回マイクロエレクトロニクス研究会(大見研究室年次研究討論会)プロシーディング、pp.199-208、1993年11月。
- 499(W) 稲葉仁、大見忠弘、吉田隆紀、岡田孝夫、「光照射静電気除去技術 "軟 X 線照射除電と真空紫外線照射除電"」、第3回マイクロエレクトロニクス研究会(大見研究室年次研究討論会)プロシーディング、pp.251-268、1993年11月。
- 500(W) 三好伸二、高橋慎治、小嶋努、末長徹男、白井泰雪、川田幸司、大見忠弘、「金属表面の  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  不動態処理及び金属ヒュームフリー溶接技術」、第3回マイクロエレクトロニクス研究会(大見研究室年次研究討論会)プロシーディング、pp.269-280、1993年11月。
- 501(P) 中村亘、牧原康二、大見忠弘、「水素ラジカル水分酸化を用いた高信頼性極薄酸化膜の形成」、半導体・集積回路技術第45回シンポジウム講演論文集 [PROCEEDINGS OF THE 45TH SYMPOSIUM ON SEMICONDUCTORS AND INTEGRATED CIRCUITS TECHNOLOGY]、(電気化学協会電子材料委員会)、pp.128-133、1993年12月。
- 502(P) 河合泰明、小西信博、渡辺仁三、大見忠弘、「450℃ゲート酸化膜形成技術」、半導体・集積回路技術第45回シンポジウム講演論文集 [PROCEEDINGS OF THE 45TH SYMPOSIUM ON SEMICONDUCTORS AND INTEGRATED CIRCUITS TECHNOLOGY]、(電気化学協会電子材料委員会)、pp.140-145、1993年12月。
- 503(M) 稲葉仁、吉田隆紀、岡田孝夫、大見忠弘、「光照射静電気除去技術“軟X線照射除電と真空紫外線照射除電”」、電磁環境工学情報EMC12月号、No.68、(ミマツデータシステム)、pp.20-28、1993年12月。
- 460-2(B) 大見忠弘、「(第1部 第2編 超高純度ガス技術の黎明)第3章 超高純度ガスの目指すところ、半導体ガス供給系の高性能化が半導体製造プロセスにいかに関与するかー半導体製造プロセスの高度化がトータルコストを低減するー」、半導体基盤技術研究会編、超高純度ガスの科学、第1分冊 コンセプト編、(株リアライズ社)、pp.97-99、1993年12月。
- 461-2(B) 大見忠弘、「(第1部 第2編 超高純度ガス技術の黎明)第3章 超高純度ガスの目指すところ、完全耐腐食性・非触媒性ステンレス表面処理技術ープロセスパラメータの完全制御を可能にする超高純度ガス配管系ー」、半導体基盤技術研究会編、超高純度ガスの科学、第1分冊 コンセプト編、(株リアライズ社)、pp.100-108、1993年12月。

- 462-2(B) 大見忠弘、「(第1部 第2編 超高純度ガス技術の黎明)第3章 超高純度ガスの目指すところ、腐食の困難を克服する金属ヒュームフリー超精密溶接技術ーコンタミフリーかつ長寿命のガス配管系を可能にする溶接技術ー」、半導体基盤技術研究会編、超高純度ガスの科学、第1分冊 コンセプト編、(株リアライズ社)、pp.109-117、1993年12月。
- 463-2(B) 大見忠弘、「(第1部 第2編 超高純度ガス技術の黎明)第3章 超高純度ガスの目指すところ、Inspection-Free Installationー高性能化と標準化が配管施工技術を変えるー」、半導体基盤技術研究会編、超高純度ガスの科学、第1分冊コンセプト編、(株リアライズ社)、pp.118-122、1993年12月。
- 464-2(B) 大見忠弘、「(第1部 第2編 超高純度ガス技術の黎明)第3章 超高純度ガスの目指すところ、Inspection-Free Installation(継手編)ー減圧リークチェック評価を不要にする新しい継手とその施工方法ー」、半導体基盤技術研究会編、超高純度ガスの科学、第1分冊 コンセプト編、(株リアライズ社)、pp.123-132、1993年12月。
- 465-2(B) 大見忠弘、「(第1部 第2編 超高純度ガス技術の黎明)第3章 超高純度ガスの目指すところ、完全自動化ガス供給システムー半導体ガス供給系の高性能化・標準化ー」、半導体基盤技術研究会編、超高純度ガスの科学、第1分冊 コンセプト編、(株リアライズ社)、pp.133-137、1993年12月。
- 504(B) 松浦孝、大見忠弘、室田淳一、小野昭一、「(第1部 第3編 超高純度ガスとシリコン表面制御技術)第9章 高純度ECRプラズマによる完全選択異方性エッチング技術」、半導体基盤技術研究会編、超高純度ガスの科学、第1分冊 コンセプト編、(株リアライズ社)、pp.247-258、1993年12月。
- 505(B) 杉山和彦、水口泰光、中村雅一、大木厚志、大見忠弘、三好伸二、川田幸司、「(第2部 超高純度ガスを支える技術開発)第1編 ガス供給系ウルトラクリーン化のコンセプト」、半導体基盤技術研究会編、超高純度ガスの科学、第1分冊 コンセプト編、(株リアライズ社)、pp.261-289、1993年12月。
- 506(B) 杉山和彦、中村雅一、大木厚志、中原文生、大見忠弘、「(第2部 超高純度ガスを支える技術開発)第2編 ウルトラクリーンガス供給系の設計論」、半導体基盤技術研究会編、超高純度ガスの科学、第1分冊 コンセプト編、(株リアライズ社)、pp.291-309、1993年12月。
- 507(B) 中村雅一、大木厚志、渡邊剛、川田幸司、大見忠弘、「(第3部 超高純度ガスの科学)第2編 モノシラン」、半導体基盤技術研究会編、超高純度ガスの科学、第1分冊 コンセプト編、(株リアライズ社)、pp.341-353、1993年12月。
- 508(M) 大見忠弘、「2001年半導体工場の収支総決算ー2(完結編)」、ブレイクスルー、No.90、(株リアライズ社)、pp.26-30、1993年12月。
- 509(P) 大見忠弘、「ー巻頭言ー高稼働率の半導体・液晶工場を目指して」、ウルトラクリーンテクノロジー Vol.5、No.5/6、(半導体基盤技術研究会)、pp.1-6、1993年12月。
- 510(P) 高橋慎治、大木厚志、大見忠弘、「ハロゲン系ガスに対する耐腐食金属表面処理技術」、ウルトラクリーンテクノロジー Vol.5、No.5/6、(半導体基盤技術研究会)、pp.37-42、1993年12月。
- 389-2(P) 中島宏幸、大澤守彦、大塚隆夫、中谷光良、馬場吉康、佐藤憲二、大見忠弘、「焼けおよびヒュームフリーの装置溶接技術」、ウルトラクリーンテクノロジー Vol.5、No.5/6、(半導体基盤技術研究会)、pp.43-50、1993年12月。
- 388-2(P) 高橋麗子、千葉和郎、前野又五郎、泉浩人、大見忠弘、「金属表面フッ化不動態膜の耐腐食性能」、ウルトラクリーンテクノロジー Vol.5、No.5/6、(半導体基盤技術研究会)、pp.51-58、1993年12月。
- 511(P) 三好伸二、末長徹男、川田幸司、大見忠弘、水口泰光、「高速1周溶接による配管施工の高性能化」、ウルトラクリーンテクノロジー Vol.5、No.5/6、(半導体基盤技術研究会)、pp.59-63、1993年12月。
- 415-2(M) 大見忠弘、「シリコンウェハ表面の洗浄と表面微細構造(マイクロラフネス)」、超精密 Vol.3、(精密工学会 超精密加工専門委員会)、pp.107-114、1993年12月。

- 512(P) 大見忠弘、新田雄久、「超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.20 序文」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 20、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.(1)-(2)、1993年12月。
- 513(P) 大見忠弘、「UCT最新研究動向」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 20、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.39-54、1993年12月。
- 514(P) 小嶋努、高橋慎治、三好伸二、大見忠弘、「ステンレス表面のCr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>不動態膜形成技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 20、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.205-214、1993年12月。
- 515(P) 堀越基伸、国本文智、塚崎和生、三好伸二、小嶋努、白井泰雪、大見忠弘、萬ヶ谷康弘、伊藤久司、添田房美、「触媒効果の無いガスフィルターを目指して」超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 20、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.215-240、1993年12月。
- 516(P) 三好伸二、白井泰雪、小嶋努、大見忠弘、「精密チューブ溶接技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 20、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.241-249、1993年12月。
- 517(P) Hiroyuki NAKASHIMA、Morihiro OHSAWA、Takao OHTSUKA、Mitsuyoshi NAKATANI、Yoshiyasu BABA、Kenji SATO、Tadahiro OHMI、「Fume-Free Welding Technology for Manufacturing Equipment」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 20、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.250-261、1993年12月。
- 518(P) 篠原努、山路道雄、池田信一、出田英二、福田浩幸、大見忠弘、「Inspection Free Installation を目指した継手」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 20、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.272-283、1993年12月。
- 519(P) 大木厚志、水口泰光、大見忠弘、「APIMSによるガス供給系外部リーク評価技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 20、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.284-290、1993年12月。
- 520(P) 村上功一、菅野洋一、内澤修、清野文之、大見忠弘、「自動化システム用バルブ」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 20、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.303-309、1993年12月。
- 521(P) Akihiro ICHIKAWA、Koji MAKIHARA、Kazuma YAMAMOTO and Tadahiro OHMI、「Wafer Transportation System with Ultraclean N<sub>2</sub> Gas Continuous Purge Function」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 20、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.310-318、1993年12月。
- 522(P) 陶山誠、森永均、能勢昌之、大見忠弘、「ウェットプロセスにおける金属不純物の粒子状付着挙動」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 20、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.331-340、1993年12月。
- 523(P) 安井信一、米川直道、大見忠弘、「オゾン添加超純水を用いたスピンクリーニング法によるシリコンウェハ表面の有機物除去」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 20、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.341-352、1993年12月。
- 524(P) 毛塚健彦、石井誠郎、畝本達也、板野充司、久保元伸、大見忠弘、「薬液中の粒子の挙動とウェハ表面への付着制御」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 20、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.353-361、1993年12月。
- 525(P) 末長徹男、川田幸司、大見忠弘、牧原康二、「ウェハキャリアボックスからの脱ガス評価」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 20、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.363-372、1993年12月。
- 526-1(P) 大見忠弘、柴田直、「しなやかな情報処理を可能にする4端子デバイスエレクトロニクス」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 20、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.580-589、1993年12月。



- 527(P) 稲葉仁、大見忠弘、吉田隆紀、岡田孝夫、「静電気対策技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 20、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.610-621、1993年12月。